

СОДЕРЖАНИЕ

Том 69, номер 4, 2024

ДИФРАКЦИЯ И РАССЕЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

- Численное моделирование эффекта фокусировки рентгеновских лучей с помощью рефракционно-дифракционной линзы 567
В. Г. Кон
- Быстрый численный расчет рентгеновской дифракции от кристаллических микросистем 575
В. И. Пунегов, Д. М. Мальков

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

- Растворение примесей в натрий-гадолиниевом молибдате $\text{NaGd}(\text{MoO}_4)_2$ 581
В. Б. Дудникова, Н. Н. Еремин

СТРУКТУРА НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

- Новые тройные интерметаллиды $R_4\text{Ru}_2\text{Ga}_3$ ($R = \text{Pr}, \text{Nd}, \text{Sm}, \text{Gd}, \text{Tb}, \text{Dy}, \text{Ho}, \text{Er}$) 589
И. А. Грехов, Ж. М. Куренбаева, Е. В. Мурашова
- Разнообразие структурных блоков $[\text{M}(\text{IO}_3)_6]$ в семействах иодатов и новая тригональная разновидность $\text{Cs}_2\text{HfIn}(\text{IO}_3)_6$ 597
О. В. Реутова, Е. Л. Белоконева, А. С. Волков, О. В. Димитрова

СТРУКТУРА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

- Галогенные связи в производных 2,5-дииод-1,4-диметилбензола 612
К. Раджакумар, Д. А. Жеребцов, С. А. Найферт, А. А. Осипов, С. А. Адонин, Д. В. Спиридонова

ДИНАМИКА РЕШЕТКИ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

- Уточнение параметров элементарной ячейки на современных монокристаллических дифрактометрах. Изучение анизотропии теплового расширения монокристалла $\alpha\text{-}^{33}\text{S}$ 620
П. С. Серебrenникова, А. В. Панченко, Н. Б. Егоров, С. А. Громилов

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ

- Индукция вязких мод разрушения льда и радикальное повышение энергоемкости его деструкции путем введения наноразмерных добавок 630
Ю. И. Головин, В. М. Васюков, В. В. Родаев, А. А. Самодуров, Д. Ю. Головин, А. И. Тюрин, С. С. Разливалова, В. М. Бузник
- Исследование температурных свойств I.H.P.-структуры и ее применение для фильтров на поверхностных акустических волнах 639
А. С. Койгеров, О. Л. Бальшева

ПОВЕРХНОСТЬ, ТОНКИЕ ПЛЕНКИ

- Морфология и пространственное распределение упорядоченных доменов в $\text{GaInP}/\text{GaAs}(001)$ по данным просвечивающей электронной микроскопии 646
А. В. Мясоедов, Н. А. Берт, Н. А. Калюжный, А. М. Минтаиров
- Тонкопленочные полидиацетилены стабильной голубой фазы на основе симметричных и несимметричных диацетиленовых *N*-арилкарбаматов 652
А. С. Алексеев, С. Ю. Вязьмин, А. Б. Иванов, В. В. Клечковская, М. С. Лукасов

НАНОМАТЕРИАЛЫ, КЕРАМИКА

Исследование электрических свойств и характеристика металлополимерного проводника на основе серебросодержащих нанопроволок

Д. В. Панов, И. С. Волчков, Н. П. Ковалец, П. Л. Подкур, И. О. Кошелев, В. М. Каневский 661

Электронные состояния зоны проводимости ультратонких пленок фуран-фениленового соолигомера на поверхности окисленного кремния и послойно выращенного оксида цинка

А. С. Комолов, И. А. Пронин, Э. Ф. Лазнева, В. С. Соболев, Е. А. Дубов, А. А. Комолова, Е. В. Жижин, Д. А. Пудиков, С. А. Пшеничнюк, К. С. Беккер, М. С. Казанцев, Ф. Дж. Акбарова, У. Б. Шаронов 670

Синтез наноразмерного твердого электролита $\text{Pr}_{1-y}\text{Sr}_y\text{F}_{3-y}$ и исследование влияния термообработки на ионную проводимость фторидной нанокерамики

Н. И. Сорокин, Н. А. Архарова, Д. Н. Каримов 676

Микрофлюидный синтез гибридных микрочастиц карбоната кальция, модифицированных наночастицами серебра

А. В. Ермаков, С. В. Чапек, Е. В. Ленгерт, П. В. Конарев, В. В. Волков, М. А. Солдатов, Д. Б. Трушина 685

РОСТ КРИСТАЛЛОВ

Влияние температуры на стабильность кластера-прекурсора кристалла термолизина

Ю. В. Кордонская, В. И. Тимофеев, М. А. Марченкова, Ю. В. Писаревский, С. Ю. Сильвестрова, Ю. А. Дьякова, М. В. Ковальчук 694

Исследование особенностей концентрационных неоднородностей при наземной отработке космического эксперимента по росту кристаллов Ge(Ga)

Е. Н. Коробейникова, В. И. Стрелов, С. И. Супельняк, В. Н. Власов 700

Переходы между равновесными и неравновесными явлениями в описании роста кристалла

В. И. Ракин 705

К вопросу о механизме роста кристаллов лактозы из пересыщенных растворов

Е. А. Фиалкова, В. Б. Шевчук, А. И. Гнездилова, Ю. В. Виноградова, В. И. Баронов 720

ПРИБОРЫ, АППАРАТУРА

Гиперспектральная рентгеновская камера на базе матриц прямого преобразования

А. И. Сафонов, К. В. Николаев, С. Н. Якунин 730

Светоизлучающие AlGaAs/GaAs-диоды на основе InGaAs скомпенсированных квантовых ям с минимизированными внутренними потерями на поглощение излучения 940 нм

Р. А. Салий, А. В. Малевская, Д. А. Малевский, С. А. Минтаиров, А. М. Надточий, Н. А. Калюжный 743
